# PSI-3552 – Fabricação e Caracterização de Dispositivos Nanoeletrônicos

**Nome:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nº USP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Lista 2 de Exercícios**

*Obs: Esta lista deve ser usada como exemplo de questões de prova.*

1. Considerando uma etapa de deposição por CVD, diferencie uma “reação homogênea” de uma “reação heterogênea”.
2. Qual a vantagem da Epitaxia comparativamente ao CVD?
3. Explique a importância do silício policristalino na fabricação de CIs.
4. Por que no processo de deposição de um metal com um equipamento do tipo *eletron-beam* é mais fácil controlar a espessura do que durante a deposição por evaporação térmica?
5. Descreva a deposição por *Sputtering* e comente as vantagens desta técnica com relação a uma deposição por *electron beam*.
6. No gráfico da taxa de deposição em função do inverso da temperatura num processo CVD, explique o regime limitado por transporte de massa.

